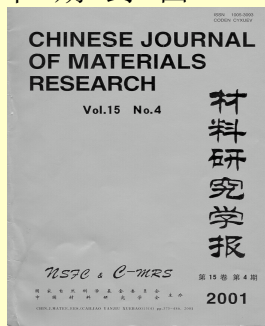


## 本期封面



2001年4

栏目:

DOI:

论文题目: 用电共沉积方法制备InGaAs薄膜

作者姓名: 王喜莲<sup>1</sup>, 李浴春<sup>1</sup>, 韩爱珍<sup>1</sup>, 高元恺<sup>1</sup>, 杨志伟<sup>2</sup>

工作单位: 1哈尔滨工业大学, 2山东大学

通信作者: 韩爱珍

通信作者Email:

文章摘要: 用电共沉积方法制备出4种InGaAs薄膜, 用能谱析仪分析了薄膜成分, 用分光光度计和单色仪测量薄膜的透射率. 结果表明,  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 薄膜为多晶结构, 晶粒尺寸约为 $0.25\mu\text{m}$ , 晶粒细致、均匀, 其V-I特性是线性的, 随着Ga含量的减少, 发光波长增大. InGaAs薄膜的发射光波长为 $1.3\sim 1.5\mu\text{m}$ .

关键词: InGaAs薄膜; 电共沉积

分类号:

关闭